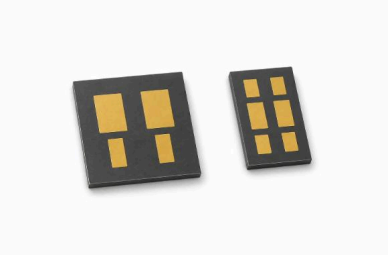
Каталог продукции

Фиксированные аттенюаторы

Фиксированные аттенюаторы вносят известное RF-ослабление для задания уровня, защиты входов или расширения диапазона измерений. Это пассивные компоненты для тестовых трактов, входов приемников, цепей драйва усилителей и калиброванных RF-линий.



Продукция: 15

Редакция: 8 · Дата редакции: 2026-11-12



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 0 dB

Ослабление: 0 dB; Входной/выходной КСВН: 1.2 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 0; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.2

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 1 dB

Ослабление: 1 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 1; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 2 dB

Ослабление: 2 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 2; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 3 dB

Ослабление: 3 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 3; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 4 dB

Ослабление: 4 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 4; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 8 dB

Ослабление: 8 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.3 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 8; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 16 dB

Ослабление: 16 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.3 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 16; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 0 dB

Ослабление: 0 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.6 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 0; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.6; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 1 dB

Ослабление: 1 dB; Входной/выходной КСВН: 1.4 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 1; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.4

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 2 dB

Ослабление: 2 dB; Входной/выходной КСВН: 1.35 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 2; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.35

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 3 dB

Ослабление: 3 dB; Входной/выходной КСВН: 1.35 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 3; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.35

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 5 dB

Ослабление: 5 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 5; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 6 dB

Ослабление: 6 dB; Входной/выходной КСВН: 1.35 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 6; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.35

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 8 dB

Ослабление: 8 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.3 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 8; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 10 dB

Ослабление: 10 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 10; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.